

従来型半導体とSiCのデバイス / 高効率パワーモジュール

SiCデバイスの特性

SiCの特長	Si	SiC
破壊耐圧(MV/cm)	0.3	3.0
バンドギャップ(eV)	1.1	3.2
熱伝導率(W/Kcm)	1.5	4.9



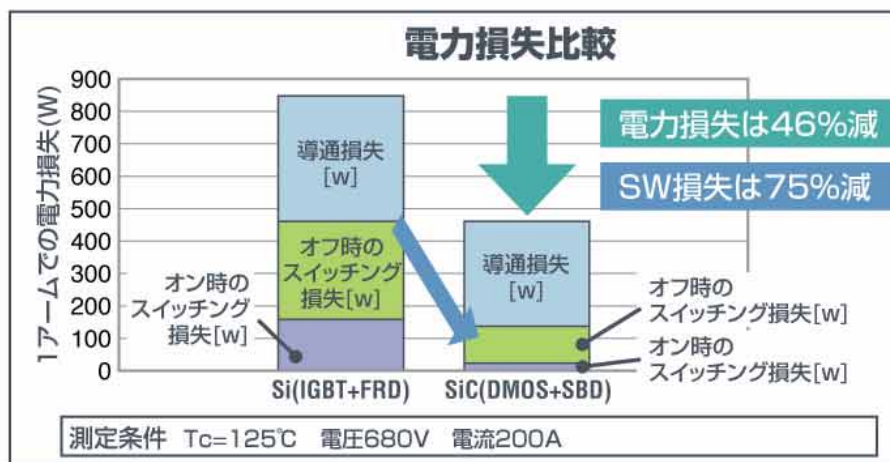
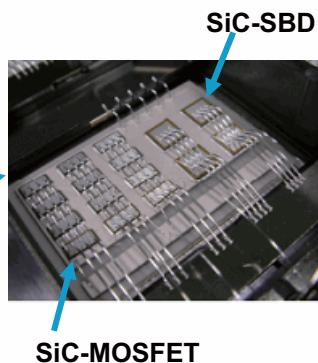
250°C以上で駆動する IPM(インバータ・パワー・モジュール)

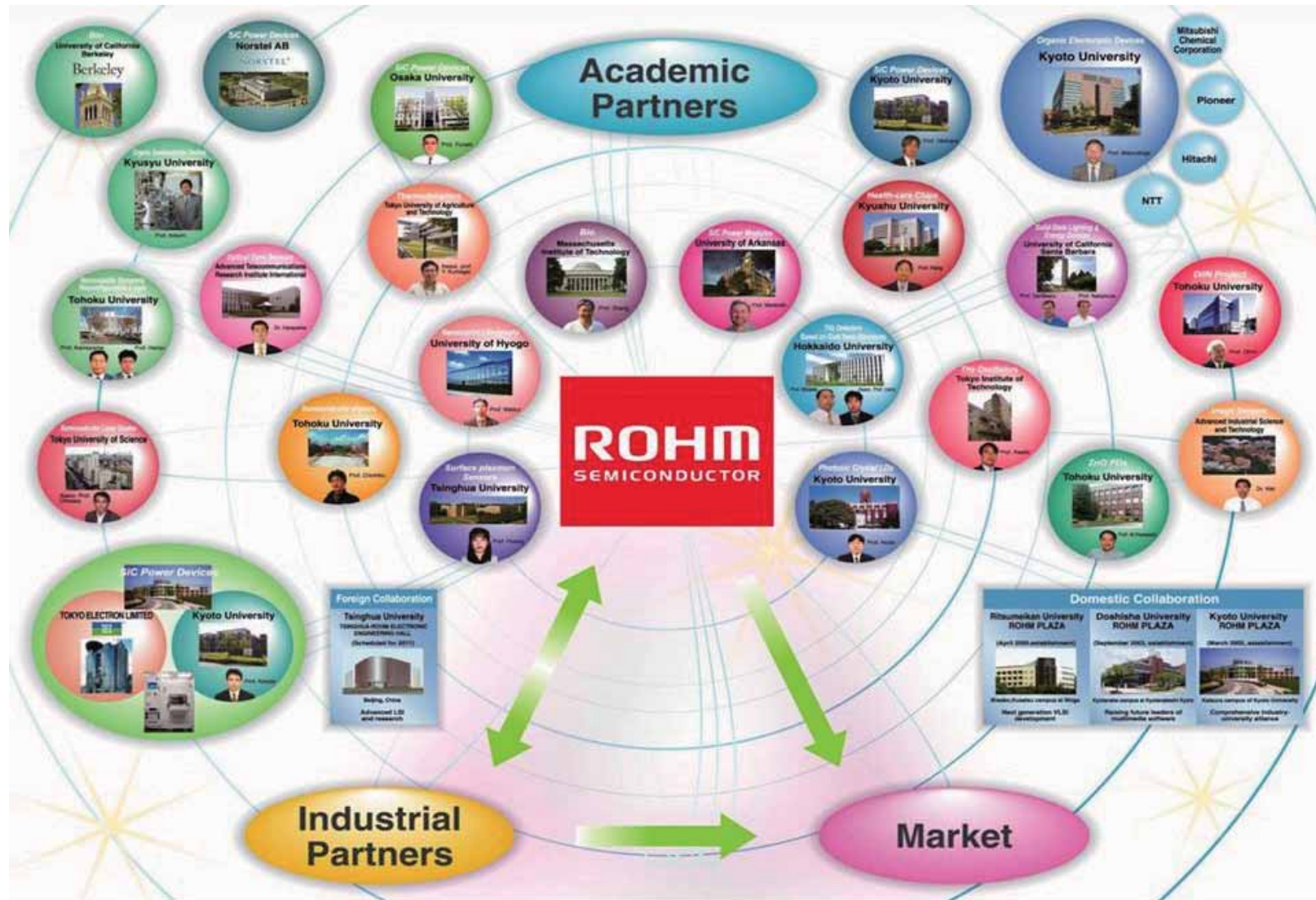
200°Cで安定動作するSiCデバイスを用いたIPMを米国の University of Arkansasなどと共同開発



SiCパワーモジュール部

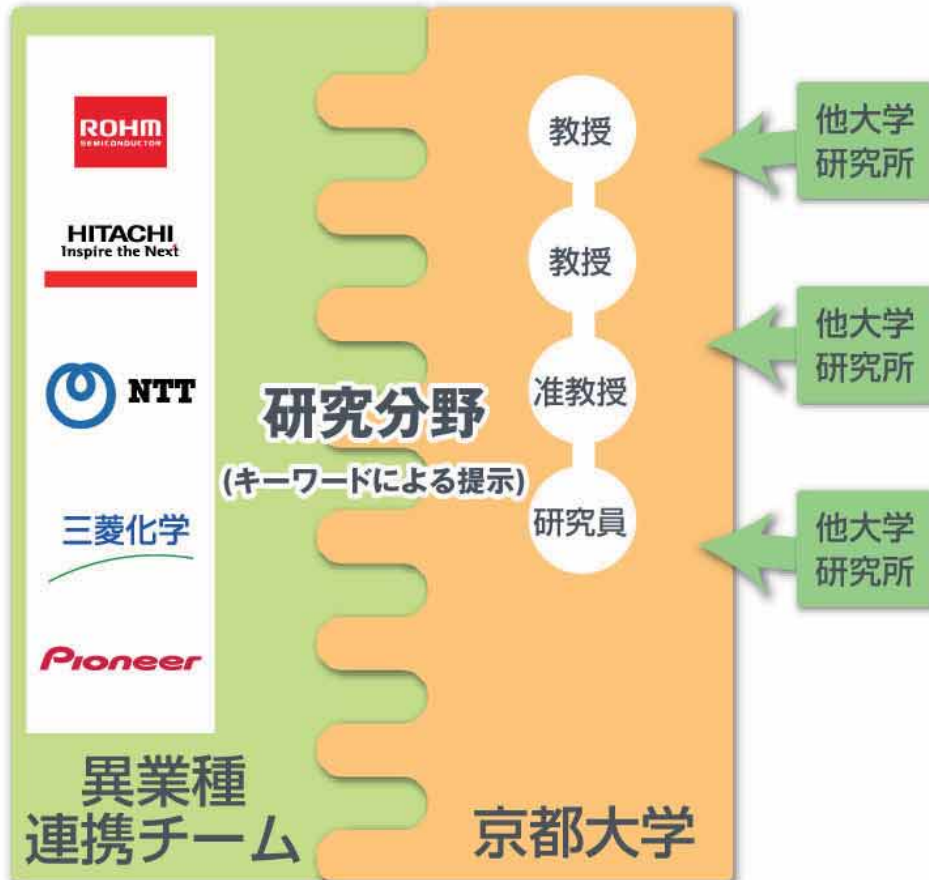
SiCデバイスでPMを作製し実際に性能を比較



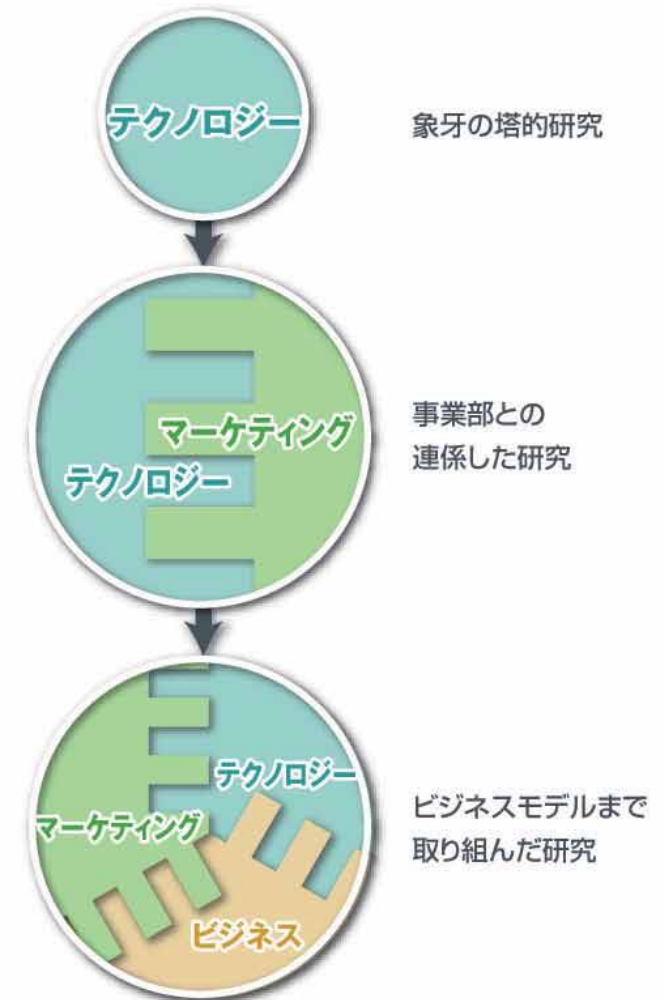


新しい戦略的産学連携の形態 (異業種交流包括的産学融合アライアンス)

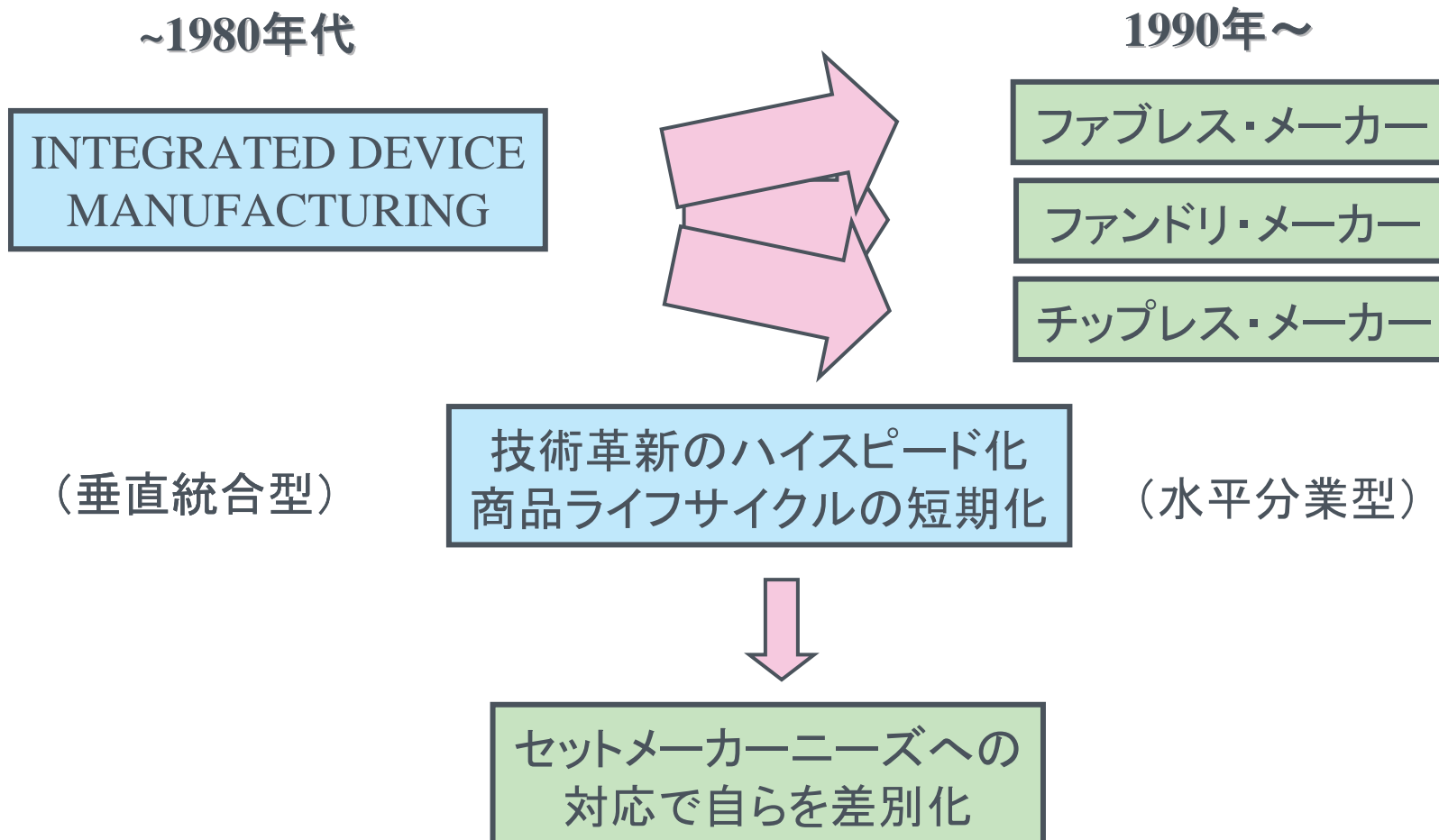
成果のIPは共同所有



テーマ設定は融合型



社会科学・人文学科も合流が必要



デファクトスタンダードで囲い込み

